

23. **М.А. Демьяненко, Д.Г. Есаев, А.И. Козлов, И.В. Марчишин, В.Н. Овсянко.** Исследование влияния структуры кремниевого мультиплектора и параметров матрицы детекторов инфракрасного диапазона на характеристики фотоприемников. *Институт физики полупроводников им А.В. Ржанова, Новосибирск.*
24. **Р.В. Левин, Д.Ю. Казанцев, Б.В. Пушной.** Выращивание и исследование варизонных слоев твердых растворов на основе антимонида галлия. *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург. ИТЦ микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург.*
25. **В.Г. Кеслер, А.А. Гузев, С.А. Дворецкий, Е.Р. Закиров, А.П. Ковчавцев, З.В. Панова, М.В. Якушев.** МДП КРТ – фотодиод с туннельно прозрачным слоем окисла. *Институт физики полупроводников им А.В. Ржанова, Новосибирск.*
26. **С.Г. Бортников, В.Ш. Алиев, И.В. Мжельский, И.А. Бадмаева.** Осцилляции тока в пленках диоксида ванадия как проявление пространственно-временной нестабильности тока вблизи фазового перехода полупроводник-металл. *Институт физики полупроводников им А.В. Ржанова, Новосибирск.*
27. **В.А. Голяшов, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, Д.В. Дмитриев, А.И. Торопов, М.С. Аксенов, Н.А. Валишева, И.П. Просвирун, А.В. Калинин, В.И. Бухтияров, А.В. Бакулин, С.Е. Кулькова, О.Е. Терещенко.** Гетероструктуры  $\text{HfO}_2/\text{Si}/\text{GaAs}(001)$  для оптических спин-детекторов. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск. Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск.*
28. **О.А. Шегай, О.Р. Баятова, А.К. Бакаров.** Фотопроводимость 2DEG  $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$  мезоструктур зигзагообразной формы. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
29. **Н.Д. Абросимова, А.Г. Гаранин, М.Н. Минеев.** Влияние стационарного рентгеновского излучения на свойства границы сращивания структур «кремний на изоляторе» со скрытым диэлектриком, модифицированным имплантацией ионов примеси. *ФГУП ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седякина, Нижний Новгород.*
30. **А.В. Никонов, К.О. Болтарь, И.Д. Бурлаков, Н.И. Яковлева.** Исследование спектральных характеристик многослойных гетероэпитаксиальных структур КРТ. *ОАО «НПО «Орион», Москва. МФТИ, Долгопрудный. МГТУ МИРЭА, Москва.*
31. **А.А.Блошкин, А.И.Якимов, В.А.Тимофеев, А.В.Дзуреченский, А.А.Кирокасян.** Процесс захвата дырок в гетероструктурах  $\text{Ge}/\text{Si}$  с квантовыми точками Ge. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск. Ереванский государственный университет, Ереван, Армения.*
32. **E. Kutlu, P. Narin, G. Atmaca, B. Sarikavak Lisesivdin, S. B. Lisesivdin.** Ab initio study of oxygen and arsenic impurities on non-linear optical properties of  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  material. *Gazi University, Faculty of Science, Department of Physics, Ankara, Turkey.*
33. **К.Д.Мынбаев, И.И.Ижнин, А.И.Ижнин, Н.Л.Баженов, А.В. Шиляев, Н.Н.Михайлов, В.С.Варавин, М.В.Якушев, С.А.Дворецкий.** Фотолюминесцентное исследование акцепторных состояний в гетероэпитаксиальных структурах  $\text{CdHgTe}$ , выращенных молекулярно-лучевой эпитаксией на подложках Si и GaAs. *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург. Научно-производственное предприятие «Карат», Львов, Украина. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск.*